

期刊信息

篇名	电子束蒸发二氧化硅膜在SiGe/Si HBT中的应用研究
语种	中文
撰写或编译	
作者	邹德恕, 陈建新
第一作者单位	
刊物名称	半导体技术
页面	1996, 2, 42-44
出版日期	1996年 月 日
文章标识(ISSN)	
相关项目	SiGe/Si异质结超高速微电子和红外光电子的器件和集成